PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-113463

(43) Date of publication of application: 18.04.2003

(51)Int.CI.

C23C 14/06 B23B 27/14 B23C 5/16 B23P 15/28

(21)Application number: 2001-295425

(71)Applicant: TOSHIBA TUNGALOY CO LTD

(22)Date of filing:

27.09.2001

(72)Inventor: KOBATA MAMORU

(30)Priority

Priority number: 2001236800

Priority date: 03.08.2001

Priority country: JP

(54) COATED MEMBER WITH TIAI ALLOY FILM AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a coated member with a TiAl alloy film, superior in machinability such as abrasion resistance, by satisfying high efficiency of cutting work.

SOLUTION: This manufacturing method comprises adjusting substrate voltage applied between a vacuum chamber and a substrate by lowering and then increasing it in a range of -20 V to -300 V continuously and/or stepwisely in a process of forming the TiAl alloy film. Thus manufactured member coated with the TiAl alloy film has superior machinability such as abrasion resistance and fracture resistance, because of being coated with the film having high residual compression stress, high oxidation resistance and satisfactory adhesiveness.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-113463 (P2003-113463A)

(43)公開日 平成15年4月18日(2003.4.18)

(51) Int.Cl.7	Ē	战別記号	FΙ		Ŧ	-73-ド(参考)
C 2 3 C	14/06		C 2 3 C	14/06	A	3 C 0 4 6
B 2 3 B	27/14		B 2 3 B	27/14	Α	4K029
B 2 3 C	5/16		B 2 3 C	5/16		
B 2 3 P	15/28		B 2 3 P	15/28	Α	

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 10 頁)

(21)出願番号	特願2001-295425(P2001-295425)
----------	-----------------------------

(22)出顯日 平成13年9月27日(2001.9.27)

(31)優先権主張番号 特額2001-236800 (P2001-236800)

(32) 優先日 平成13年8月3日(2001.8.3)

(33)優先権主張国 日本 (JP)

(71)出願人 000221144

東芝タンガロイ株式会社

神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリ

ッドスクエア

(72) 発明者 木幡 護

神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア 東芝タンガロイ株式会社内

Fターム(参考) 30046 FF10 FF23

4KO29 BA41 BA54 BA55 BA58 BA60 BB02 BC01 BD05 CA04 CA13

(54) 【発明の名称】 TiAl化合物膜被優部材およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 近年切削加工の高能率化が求められ、従来の TiAl化合物膜被覆部材より耐摩耗性などの切削性能 が優れるTiAl化合物膜被覆部材が求められるように なった。

【解決手段】 TiAl化合物膜形成工程中に該真空容器と該基材間に印加する基材電圧を-20V~-300 Vの範囲で連続的および/または段階的に降下させたのち上昇させるという調整を行いTiAl化合物膜を被覆した。こうして作製されたTiAl化合物膜被覆部材には残留圧縮応力と耐酸化性が高く密着性の良い被膜が被覆されているため、従来品に比べ耐摩耗性、耐欠損性などの切削性能が高い。

【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも一つのエッジ稜線を有する形状に形成された基材の表面に単層膜または多層膜の被膜が被覆された被覆部材において、該被膜は、TiとAlを含む窒化物、炭化物、炭窒化物、炭酸化物、塩酸化物、炭窒酸化物の中の少なくとも1種からなるTiAl化合物膜を含み、該エッジ稜線の近接部における該TiAl化合物膜は、Ti/Al原子比が該TiAl化合物膜内で最大となる第1膜層と、該第1膜層に対しTi/Al原子比が小さい第2膜層とを含む少なくとも2層の多層 10膜からなり、該エッジ稜線の近接部を除いた該TiAl化合物膜表面の中心部におけるTiAl化合物膜は、Ti/Al原子比が一定である単層膜からなるTiAl化合物膜被覆部材。

【請求項2】前記第1膜層は、Ti/Al原子比が前記基材の表面側から該TiAl化合物膜の内部に向かって連続的および/または段階的に増加したのち最大となり、その後該TiAl化合物膜の表面側に向かって減少する請求項1に記載のTiAl化合物膜被覆部材。

【請求項3】前記エッジ稜線の近接部は、該エッジ稜線 20 から該TiAl化合物膜表面の中心部に向かって幅2mm以内の領域である請求項1または2に記載のTiAl化合物膜被覆部材。

【請求項4】前記エッジ稜線の近接部におけるTiA1 化合物膜は、膜厚さ方向で前記第1 膜層が前記第2 膜層で挟持された3 層でなり、該第1 膜層、該第2 膜層のTi/A1 原子比をそれぞれA、B と表したときに、0. $90 \le A \le 2$. 00、および0. $82 \le B \le 1$. 50 である請求項3に記載のTiA1 化合物膜被覆部材。

【請求項5】前記TiAl化合物膜は(Tix, Aly) Nzで表され、x は金属元素中のTi の原子比、y は金属元素中のAl の原子比、z は、Ti とAl の合計に対するN の原子比を表し、それぞれがx+y=1、0.66 egreentering eqreentering eqreentering eqreentering equation <math>egreentering eqreentering eqreentering equation <math>egreentering eqreentering eqreentering equation <math>egreentering eqreentering eqreentering equation <math>egreentering eqreentering eqreen

【請求項6】前記TiAl化合物膜は、(Tia, Alb, Mc)Naで表され、MはZr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Si、B、Mg、Fe、Sn、Mn、Sc、Y、ランタン系希土類元素の中の少なくと 40も1種を表し、aはTiとAlとMの合計に対するAlの原子比、cはTiとAlとMの合計に対するMの原子比、dはTiとAlとMの合計に対するMの原子比、dはTiとAlとMの合計に対するNの原子比を表し、それぞれがa+b+c=1、0.66 \ge a \ge 0.32、0.54 \ge b \ge 0.24、0.3 \ge c \ge 0、1.05 \ge d \ge 0.7の関係にある請求項1~4のいずれか1項に記載のTiAl化合物膜被覆部材。

【請求項7】前記TiAl化合物膜は、(Tia, Alb, Ma) Naで表され、MはV、Nb、Ta、Cr、

Mo、W、Y、Mnの中の少なくとも1種を表し、aは TiとAlとMの合計に対するTiの原子比、bはTiとAlとMの合計に対するAlの原子比、cはTiとAlとMの合計に対するMの原子比、dは、TiとAlとMの合計に対するNの原子比を表し、それぞれがa+b+c=1、0.66 \geq a \geq 0.32、0.54 \geq b \geq 0.24、0.3 \geq c \geq 0、1.05 \geq d \geq 0.7の関係にある請求項6に記載のTiAl化合物膜被覆部材。 【請求項8】前記被膜は、Ti、Tiの炭化物、窒化物、炭窒化物、炭酸化物、炭窒酸化物の中の

物、炭窒化物、炭酸化物、窒酸化物、炭窒酸化物の中の少なくとも一種の下層膜を含み、該下層膜が前記基材と前記TiAl化合物膜との間に介在されている請求項1~7のいずれか1項に記載のTiAl化合物膜被覆部材。

【請求項9】前記被膜は前記TiAl化合物膜の他に、Ti、Tiの炭化物、窒化物、炭窒化物、炭酸化物、窒酸化物、炭窒酸化物の中の少なくとも一種でなる最外層を含み、該TiAl化合物膜の表面に該最外層が被覆されている請求項1~8のいずれか1項に記載のTiAl化合物膜被覆部材。

【請求項10】前記基材が鉄系金属材料、非鉄系金属材料、超硬合金、サーメット、セラミックス焼結体、または超高圧焼結体の少なくとも一種である請求項1~9のいずれか1項に記載のTiAl化合物膜被覆部材。

【請求項11】前記TiAl化合物膜被覆部材は、切削工具である請求項10に記載のTiAl化合物膜被覆部材

【請求項12】真空容器内に少なくとも一つのエッジ稜線を有する基材を担持し、該基材表面に単層膜または多層膜の被膜を被覆する工程において、少なくとも一工程がTiAl化合物膜形成工程であり、該TiAl化合物膜形成工程中に該真空容器と該基材間に印加する基材電圧を-20V~-300Vの範囲で連続的および/または段階的に降下させたのち上昇させるという調整を行うTiAl化合物膜被覆部材を製造する方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明はTiAl化合物膜を被覆した部材に関するものである。

[0002]

【従来の技術】工具や耐摩耗部品の特性向上のため(Ti, A1)Nを金属材料あるいは超硬合金の上に形成した硬質膜被覆部材が広く用いられている。近年、被膜特性および基材との密着性を向上させるため特開平3-188265号公報、特開平6-316756号公報、特開平8-267306号公報が提案されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】特開平3-18826 5号公報には母材の表面から被覆層表面に向かってTi 50 の炭化物、窒化物または炭窒化物からTiとAlの合金

Ti1-xAlx (0 < x ≦ 0.7) の炭化物、蜜化物また は炭窒化物まで変化した被覆層が提案されているが、被 覆層の残留圧縮応力が低いため耐欠損性や耐摩耗性が十 分に確保されない。特開平6-316756号公報には TiAlN被膜においてAlの原子濃度が0.6以下で あり、かつA1濃度の異なる3層以上のTiA1N被膜 からなる積層構造であり、上記TiA1N被膜により挟 まれたTiAlN中間被膜におけるAl濃度が上下のT iAlN被膜より小さい層を含むことを特徴とする耐食 ・耐摩耗性被膜が提案されているが、切削工具に用いた 場合、被膜が剥離しやすいため、十分な性能が得られな い。特開平8-267306号公報には基材表面に被覆 されたTiAl化合物層はTiAl化合物層のTi/A 1原子比(以後Ti/A1比と表示する)が基材表面と 平行な方向に変化しておりかつエッジ部において最も高 くなっていることを特徴とする硬質層被覆切削工具が提 案されている。エッジ稜線と面方向にエッジ稜線より幅 2mmを超えた領域の被膜組成が異なるが、切削工具と して用いた場合、温度が上がるエッジ稜線でTiAl化 合物層のTi/Al比が高いため被膜が酸化しやすいと いう欠点があり、TiAl化合物層の表面にTiNを被 覆してもTiNの耐摩耗性が劣るため早期にTi/Al 比が高いTiAl化合物層が露出するためやはり酸化し やすいという問題が残る。そこで本発明は密着性が高く 耐酸化性に優れ欠けにくいTiAl化合物膜被覆部材お よびその製造方法の開発を目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】発明者は、TiAl化合物膜の強度や密着性を上げる手段を種々検討した結果、TiAl化合物膜形成工程中に真空容器と基材間に印加 30 する基材電圧を-20V~-300Vの範囲で連続的および/または段階的に降下させたのち上昇させるという調整を行ってTiAl化合物膜を被覆した部材が優れた性質を示すことを見出した。

【0005】本発明のTiAl化合物膜被覆部材製造方 法の特徴はTiAl化合物膜被覆時の基材電圧を制御す ることであり、本発明の製造条件で作製されたTiA1 化合物膜に含まれるTiとAlの比率の分布は特徴的で ある。少なくとも一つのエッジ稜線を有する形状の基材 にTiAl化合物膜を形成するとTi/Al比が最大と なる第1膜層と、第1膜層に対しTi/Al比が小さい 第2膜層が少なくとも2層の多層膜からなるTiAl化 合物膜がエッジ稜線の近接部に形成され、エッジ稜線の 近接部を除いたTiAl化合物膜表面の中心部における Ti/Al比は一定であるTiAl化合物膜が形成され る。切削工具として使用する場合、エッジ稜線の近接部 におけるTiAl化合物膜は、膜厚さ方向で該第1膜層 が該第2膜層で挟持された3層でなり、該第1膜層、該 第2膜層のTi/Al原子比をそれぞれA、Bと表した ときに、0.90≦A≦2.00、および0.82≦B 50 覆される。

≦1.50であるTiA1化合物膜被覆部材が好まし い

[0006]

【発明の実施の態様】少なくとも一つのエッジ稜線を有する形状は、例えばJIS規格B4104-1989、該規格B4114-1993、該規格B4115-1993、該規格B4115-1983、該規格B4117-1991、該規格B4120—1985、該規格B4121—1985、該規格B4122—1985、該規格B4123—1985に示される工具、製缶工具、冷間加工用金型、熱間加工用金型があげられる。

【0007】TiA1化合物膜は物理蒸着法(以後PVD法と表示する)で作製されるのが好ましいが、PVD法の中でもアークイオンプレーティング方式を用いると密着性に優れるので特に好ましい。本発明品を作製する方法として、組成が異なるターゲットを2種類以上使用してコーティングする方法①とコーティング時に該真空容器と該基材間の基材電圧を変える方法②を例示できる。方法①によって本発明品を作製する場合、組成が異なる2種類以上のターゲットを用意しなければならず、コーティング中にパラメーターを頻繁に変えるため工程が複雑化し技術的に非常に難しい。方法②によって本発明品を作製する場合、最少限のターゲット、基本的には1種類のターゲットを用いればよくコーティング中にパラメーターを制御することで本発明品を得られるため、工程が簡累化され好ましい。

【0008】方法②について詳しく述べると、PVD法による被覆工程を、基材をガス雰囲気調整可能な真空容器内に設置する第1工程と、真空容器内を真空排気ののち基材を加熱し基材表面をエッチングし真空容器内を被膜形成するためのガス雰囲気とする第2工程と、被膜を形成する際にプラズマ雰囲気中でイオンを高電圧の電源で加速する第3工程に大別した場合、第3工程の中でTiAl化合物膜を被覆する工程中に基材電圧を連続的および/または段階的に降下させたのち上昇させる調整を行うことによって本発明品が得られる。

【0009】基材電圧を高くした条件で作製した被膜は基材電圧を低くした条件で作製した被膜よりも残留圧縮応力が小さく、密着性向上には有利であるが、被覆温度が低いため熱拡散が少なく実際には密着性が低い。一層のTiA1化合物膜について膜厚さ方向におおよそ3分割し、基材に近い部分を基材側、上下に挟まれた部分を中間部分、表面に近い部分を表面側とした場合、TiA1化合物膜の基材側を、基材電圧を低くした条件で被覆すると、被覆温度が高いため熱拡散が生じ密着性向上に有利であるが、強い残留圧縮応力により剥がれやすいので好ましくない。本発明のTiA1化合物膜被覆工程ではTiA1化合物膜の基材側を被覆するとき基材電圧をして0~-40Vとして残留圧縮応力の小さい被膜が被

【0010】次いでTiAl化合物膜の中間部分を被覆 する工程中、基材電圧を図1~図4に例示したように-20~-40 Vから-200~-300 Vまで連続的お よび/または段階的に降下させる。基材電圧が低い条件 で作製した被膜は基材電圧が高い条件で作製した被膜よ りも残留圧縮応力が高い。基材電圧を-20~-40V から急にまたは不連続的に-200~-300Vに下げ ると基材側と中間部分の間で剥離する可能性が高くな る。これは中間部分の高い残留圧縮応力によるものと考 えられる。本発明のように基材電圧を-20~-40V 10 から-200~-300Vまで連続的および/または段 階的に降下させると、TiAl化合物膜の残留圧縮応力 が連続的および/または段階的に高くなるため基材側と 中間部分の間で剥離しにくくなる。高い残留圧縮応力を 持つTiAl化合物膜の中間部分は耐欠損性や耐摩耗性 に優れる。また基材電圧が低い条件で被膜を被覆すると イオンの運動エネルギーが高くなるため、被覆温度が上 昇しイオン注入効果が増大する。TiAl化合物膜の中 間部分の被覆時に生じる高い温度とイオン注入効果はT iAl化合物膜の基材側にも影響をおよぼし、温度の上 20 昇やイオン注入効果によってTiAl化合物膜の基材側 の密着性が高くなる。これはサーマルスパイク効果と呼 ばれる。

【0011】基材電圧はTiAl化合物膜の組成にも影 響をおよぼす。基材電圧が高い条件で被覆したTiA1 化合物膜のTi/Al比は均一であるが、基材電圧が低 い条件でTiAl化合物膜を被覆した場合、面方向にエ ッジ稜線から2mm超えた領域のTiAl化合物膜のT i/Al比に比較して面方向にエッジ稜線から幅2mm 以内の領域のTiAl化合物膜のTi/Al比が高くな 30 る。これはエッジ効果と呼ばれる。TiA1化合物膜の 硬さと耐酸化性はTi/Al比が0.7付近のとき最も 高く、それよりもTiリッチまたはAlリッチになると TiAl化合物膜の硬さと耐酸化性は低下する。本発明 のTiAl化合物膜のTi/Al比は0.7以上であ り、Ti/Al比が高くなるとともに硬さと耐酸化性は 低下する。したがって、基材電圧を低くして被覆する と、エッジ効果により面方向にエッジ稜線から幅2mm 以内の領域のTiAl化合物膜のTi/Al比が高くな ることで硬さの低下が懸念されるが、実際は残留圧縮応 40 力が高くなるため、見かけ上の硬さが高くなり耐摩耗性 が向上する。耐欠損性についても残留圧縮応力が高くな るため向上する。

【0012】次に基材電圧を-200~-300Vから し、それ -20~-40Vまで上昇させる。TiAl化合物膜の 0.54 表面側は基材電圧を高くした条件で被覆する。エッジ効 を満たす 単がほとんどなくなったTiAl化合物膜の表面側はT 超える場 i/Al比が均一となり面方向にエッジ稜線から幅2m の被膜を m以内の領域の耐酸化性が向上する。またTi/Al比 合、Ti は均一であるため被膜表面の色調が均一になり使用コー 50 下する。

ナー識別が容易になる。

【0013】以上のような機能を持たせるためTiAl化合物膜を被覆する工程中、基材電圧を連続的および/または段階的に降下させたのち上昇させる。本発明品を断面観察すると面方向にエッジ稜線から幅2mm以内の領域のTiAl化合物膜の中間部分のTi/Al比が高いことを確認できる。TiAl化合物膜が数μm程度の厚さであれば光学顕微鏡観察により確認できる場合もある。

【0014】基材電圧が-20V未満ではイオンの運動エネルギーが低下するためTiA1化合物膜の密着性が低下する。基材電圧が-300Vを超えるとTiA1化合物膜の残留圧縮応力が高くなり過ぎチッピングを起こしやすくなる。そのため基材電圧の範囲を-20~-300Vとした。アーク電圧は35~45V、アーク電流は130~170A、窒素源としてはN2=160~220SCCMが好ましい。金属原料ターゲットはTiターゲットとA1ターゲットと分けて装着するよりもTiとA1を同時に含むターゲットを装着することが好ましく、前記ターゲットに含まれるTiとA1の原子比は0.8

【0015】前述のようにTiAl化合物膜のTi/A 1比は、被膜の硬さ、耐酸化性に影響をおよぼす。 Ti A1化合物膜の硬さと耐酸化性はTi/A1比がO.7 付近のとき最も高く、それよりもTiリッチまたはAl リッチになるとTiA1化合物膜の硬さと耐酸化性は低 下する。Ti/Al比が2.00を超えると所望の硬さ が得られず、Ti/A1比が0.82以下になると硬さ の低い六方晶構造のTiAl化合物膜を生成する可能性 が高くなる。そのためTiAl化合物膜のTi/Al比 は0.82≦Ti/A1比≦2.00が好ましく、エッ ジ稜線の近接部におけるTiAl化合物膜が、膜厚さ方 向で第1膜層が第2膜層で挟持された3層構造である場 合、エッジ効果によりTi/Al比が高い第1膜層は 0.90≦Ti/A1比≦2.00が好ましく、エッジ 効果が生じない第2膜層は0.82≦Ti/A1比≦ 1.50が好ましい。

【0016】 TiAl 化合物膜はTiとAlを含む窒化物、炭化物、炭窒化物、炭酸化物、炭酸化物、炭酸金化物、炭酸金化物の少なくとも一種からなるTiAl 化合物の膜であるが、その中でも(Tix, Aly)Nzで表され、xは金属元素中のTiの原子比、yは金属元素中のAlの原子比、zは、TiとAlの合計に対するNの原子比を表し、それぞれがx+y=1、0.66 $\ge x\ge 0$ 0.46、0.54 $\ge y\ge 0$ 0.34、1.05 $\ge z\ge 0$ 0.7の関係を満たすTiAl 化合物膜が好ましい。Zが1.05を超える場合、TiAl 化合物膜が立方晶構造以外の構造の被膜を含むため硬さが低下する。Zが0.7未満の場合、TiAl 化合物膜中に空孔が多くなるため硬さが低下する。

【0017】TiAl化合物膜としては(Tix, A ly) Nzに加えて第3の金属成分を含んだ(Tia、A lb, Mc) Noもよい。具体的には (Tia, Alb, Mc) Noで表され、MはZr、Hf、V、Nb、Ta、 Cr. Mo. W. Si. B. Mg. Fe. Sn. Mn. Sc、Y、ランタン系希土類元案の中の少なくとも1種 を表し、aはTiとAlとMの合計に対するTiの原子 比、bはTiとAlとMの合計に対するAlの原子比、 cはTiとAlとMの合計に対するMの原子比、dはT れがa+b+c=1、0.66 $\geq a \geq 0$.32、0.5 $4 \ge b \ge 0$. 24, 0. $3 \ge c \ge 0$, 1. $0.5 \ge d \ge d$ 0. 7の関係にあるTiAl化合物膜も好ましい。その 中でもMがV、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Y、Mn の中の少なくとも1種である場合、耐摩耗性が良く特に 好ましい。なお第3の金属成分の原子比Cは0.3を超 えると (Tia, Alb, Mc) Na被膜の結晶性が低下す るため、0.3≥c≥0と定めた。

【0018】TiAl化合物膜を被覆する基材として は、PVD法により被覆可能な基材であれば問題なく、 特に鉄系金属材料、非鉄系金属材料、超硬合金、サーメ ット、セラミックス、または超髙圧焼結体に被覆すると 耐摩耗性および耐酸化性が高くなり好ましい。その中で も超硬合金、サーメットを基材に用いた場合、基材に靱 性、TiAl化合物膜に耐摩耗性および耐酸化性を持た せることができるため、さらに好ましい。形状としては 少なくとも一つのエッジ稜線を有する基体であれば良

く、その中でもスローアウェイチップ、エンドミル、ド リルなどの切削工具に本発明を適用すると効果が高く好 ましい。

【0019】本発明のTiAl化合物膜を基材に被覆す る場合、直接被覆しても良いが、TiN、TiC、T (C, N), Ti (C, O), Ti (N, O), Ti (C, N, O) などのTi化合物やTiなどの金属膜を 下層膜、本発明のTiAl化合物膜を上層膜としてもよ い。また本発明のTiAl化合物膜を重ねて被覆し2層 iとAlとMの合計に対するNの原子比を表し、それぞ 10 以上の多層膜にしてもよい。また、外観色を改善するた め本発明のTiAl化合物膜の表面にTiN、TiC、 T (C, N), Ti (C, O), Ti (N, O), Ti (C, N, O) などの Ti 化合物膜や Ti などの 金属膜 を最外層膜として被覆してもよい。

[0020]

【発明の実施の形態】

【実施試験1】基材としてK10相当のWC超硬合金で ISO規格SNGA120408形状のスローアウェイ チップを用意し、アルカリ洗剤を使用し表面を洗浄し 20 た。スローアウェイチップは真空炉内に設置し真空排気 を行った. 真空炉内の圧力が1. 33×10-2Pa以下 になったら表1に示すように設定温度500℃まで加熱 した. 圧力が1. 33×10⁻² Pa以下に戻ったことを 確認し、表1に示すエッチング、コーティングの条件を 設定してPVDコーティング処理した.

[0021]

【表1】

0	

	9.								10		
試料名	工程	ターケ	7-7	ア-ク	基材電圧 ^{在2)}	カ	スロ	*	12②	tro	時
		71	延	電技	(V)		抗量	8	茂量	₽	11
			性1)	(A)		顫	(accou	類	(SCCM)	温	(分)
]			(V)						1	座	
										(C)	
実施例1	加無			-		_	_	-		500	60
	エッチンク	Ti	38	120	-600	Ar	50	N,	20	500	15
	(DK(LA,iT)	TiAl	38	150	∙4 0	N _t	200	-	_	500	50
	(Ti,AI)N(2)	TiAl	38	150	-40→-300 ** ¹⁰ .	N,	200	ł	_	500	50
	(E)M(LA,IT)	Tial	38	150	-40	N _z	200	-		500	50
宮護何2	加熱	_	1	-		-	_			500	60
	エッテンク	Ti	38	100	-650	Ar	40	N,	20	500	10
	(D'A(LAZT)	TiAl	38	150	-30	N,	200	_	_	500	35
	(TIAL)NO	TiAI	38	150	-70	N,	200	_	_	500	5
1	(EM(LAZT)	TiAl	38	150	-190	N,	200		_	600	5
1	(Tial)N®	TiAl	38	150	-200	N,	200			500	5
	(TIAL)N(D	TiAl	38	150	-250	N,	200	_	_	500	10
	(Tial)N®	TiAl	38	150	·160	N,	200	_		500	5
1	(Tial)NO	TiAl	38	150	-70	N,	200	_	-	500	5
	(TIAL)N®	TiAl	38	150	-40	N,	200	1	_	500	5
比較例 3	加熱		-		•	ı	-		_	600	60
	エッチンク *	Tial	38	120	-600	Ar	60	N ₂	70	500	15
	(Ti,Al)N	TiAl	36	100	-100	N,	200	-	_	500	50
比較何2	加熱	_	ı	_	ı	ľ	1	1	_	500	60
	エッチング	Ti	38	90	-600	Ar	50	N,	70	500	15
1	(DA(LA,iT)	Τĭ	35	90	-300	N,	180	-		500	15
1		TiAl	32	50							
	(Tial)NO	Ti	35	70	-300	N,	190	-	_	500	15
		TiAl	35	80							
	(E)M(IA,TT)	Ti	35	90	-300	N,	180	-	-	500	15
		TiAl	32	50							
比較何3	加熱				_					500	60
	エッチング	Ti	38	120	-1000	Ar	60			700	5
	Tin	Ti	38	120	-200	N _z	180	-		700	10
	(Ti,AI)N(I	Tial	38	120	-20	N,	180		_=_	700	10
	(TLAL)NO	Tial	38	120	-60	N _z	180		_	700	10
	(Ti,Al)N(3)	TiAl	38	120	·150	N,	180	_	_	700	10
L	(TLAI)N@	TiAl	38	120	-300	N _z	180	_		700	10

注1) 蒸発源の陽極と陰極の間のアーク電圧

*1) = 50:50 (原子比) のターゲットを示し、Ti

注2) 基材と真空容器の間の基材電圧

30 はTiターゲットを示した。作製した試料の膜厚とTi

注3) 基材電圧を50分かけて-40Vから-300V

/A1比を表2に示した。

まで連続的に降下した。

[0023]

【0022】使用ターゲット欄のTiAlは(Ti, A*

【表 2】

試料名	被膜の	TIAI 化合物酶または TIN 展						
	推築	・ 構造	膜澤	エッジ	エッジから	(u m)		
			(µm)	近撞部	2 mm 離れ	i i		
				O TVAI	た箇所の			
				比	TVA1 LL			
	L			(原子比)	(原子比)			
実施例 1	(TLAI)N	基材码(TS,AI)N	1.5	1.10	1.10	3.3		
		中間部分(Ti,Al)N	1.0	1.30				
		表面例(Ti,Al)N	0.8	1.10				
実施例 2	(Ti,AI)N	基材值(Ti,Al)N	1.5	1.10	L.10	8.9		
		中間部分(Ti,AI)N	1.0	1.30				
		表面何(Ti,Al)N	0.8	1.10				
比較例1	(TLADN	均一组成(Ti_Al)N	3.0	1.18	L12	3.0		
比較何2	(Ti,Al)N	基材制(Ti,Al)N	LO	1.89	1.22	3.1		
		中間部分(Ti,Al)N	1.1	1.19	1.09			
	1	表面侧(Ti,AI)N	1.0	1.39	1.22	l		
比較例3	第1層	Tin	0.3	_	_	3.0		
	Tin	美材倒(TI,ADN	0.6	1.08	1.08			
	+	中間部分基材製(Ti_AL)N	0.6	L11	1.12	ł		
	郡2層	中間部分表面例(Ti_AI)N	0.8	1.36	1.25			
	(Ti_AI)N	表面向CLADN	0.7	1.45	1.28			

【0024】作製した実施例 $1\sim2$ および比較例 $1\sim3$ ッチ試験を行いエッジ稜線の近接部の被膜が剥離する臨に対してロックウェルダイヤモンド圧子を用いたスクラ 50 界荷重(スクラッチ強度)を測定した。また、被削材に

S48C (HB205~223) を用い、切削速度: V = 150m/min、切り込み: d=1. 5mm、送り: f=0. 3mm/rev. 水溶性切削油使用という切削条件で旋盤による切削試験を20分間行った。表3にスクラッチ強度と切削試験後の逃げ面摩耗量VBを記載した。表3に示されるように実施例1~2は比較例*

*1~3よりもスクラッチ強度が高く、逃げ面摩耗量VB も小さい。このことから実施例1~2は比較例1~3よ りも被膜と基材の密着性が高く、摩耗しにくいことが分 かる。

[0025]

【表3】

試料名	スクラッチ強度	逃げ面摩耗量
	(N)	(mm)
実施例1	85	0.07
実施例 2	80	0.06
比較例1	60	0.12
比較例 2	65	0.12
比較例3	70	0.11

[0026]

※った。

【実施試験2】ターゲットにTiAlYを用い表4に示す条件でコーティングした以外は実地試験1と同様に行※

[0027]

【表4】

基材電圧(82) 試料名 ターゲット アーク 7.7 ガス① ガス(2) 工程 加 据推 (V) 茂量 浅里 MI 圧 rsccs₀ 温 (分) (A) (V) 実施網3 加熱 60 500 1ッチング 35 120 -600 70 Ti AT 60 N, 500 15 (TLALY)NO TAIN 38 150 -30 N, 200 500 50 TLAIY -30→-200 EE 5) N₂ (TLALY)N(2) 150 200 500 10 -200→-30 ^{16 4} Ñ, (DA(Y, LA, LT)) TIALY 38 150 200 500 5 (TLALY)N® TIAIY 38 150 -30 N, 200 500 15 実施例4 加熱 500 60 Ñ, Ti 35 120 -600 60 70 エッチング AT 500 15 (Ti,AL,Y)CNO TIAIY 38 150 -30 N, 200 CH, 70 500 50 -30→-200 #2.00 (TLALY)CN2 TIAIY 38 150 Ñ, 200 CH. 70 500 ·200→·30 # 4 N₁ (Ti.Al,Y)CN(3) TIAIY 88 200 CH 70 500 150 6 N, (TY,AI,Y)CNO TLAIY 38 150 -30 200 CH, 70 500 15 比較何4 加勢 500 60 TIAIY 35 130 -600 Ar 60 70 500 15 エッチンク N (TLALY)N Tialy 150 -200 Ar 20 N, 195 500 40 35 比較何 5 加熱 500 60 エッチング TIAIY 38 120 -600 60 70 500 15 (TLALY)CN TIAIY 35 150 -200 N2 195 CH, 65 | 500 | 40

- 注1) 蒸発源の陽極と陰極の間のアーク電圧
- 注2) 基材と真空容器の間の基材電圧
- 注3) 基材電圧を10分かけて-30Vから-200V まで連続的に降下した。
- 注4) 基材電圧を5分かけて-200Vから-30Vまで連続的に上昇した。

【0028】使用ターゲット欄のTiA1Yは(Ti,A1,Y)=45:45:10(原子比)のターゲットを示し、TiはTiターゲットを示した。作製した試料の膜厚とTi/A1比を表5に示した。なお、Yの原子比はいずれの実施例、比較例でも基材電圧による顕著な変化は見られなかった。例えば、実施例3の中間部分

(Ti, Al, Y) N膜を分析したところエッジ稜線の近接部の金属成分原子比は (Ti, Al, Y) = 50. 4:39. 6:10、面方向にエッジ稜線から幅2mmを超えた領域の金属成分原子比は (Ti, Al, Y) = 47.9:42.1:10であり、比較例4の中間部分(Ti, Al, Y) N膜を分析したところエッジ稜線の近接部の金属成分原子比は (Ti, Al, Y) = 50.4:39.6:10、面方向にエッジ稜線から幅2mmを超えた領域の金属成分原子比は (Ti, Al, Y) = 47.9:42.1:10であった。

[0029]

【表5】

	13				14	
試料名	被膜の種類	TiAl 化合物膜				
		構造	膜厚	エッジ近	エッジから2	(µm)
	1		(µm)	接部の	mm 離れた箇	1
	İ			Ti/Al It	所の Ti/Al 比	
				(原子比)	(原子比)	
実施例3	(Ti,ALY)N	基材倒(Ti,Al,Y)N	1.0	1.14	1.14	3.4
		中間部分(Ti,Al,Y)N	1.3	1.27]	
		表面側(Ti,Al,Y)N	1.1	1.14]	
実施例4	(Ti,Al,Y)N	基材側(Ti,Al,Y)CN	1.0	1.13	1.13	3.5
		中間部分(Ti,Al,Y)CN	1.3	1.28	1.14	
		表面側(Ti,Al,Y)CN	1.1	1.14	1.14	1
比較例4	(Ti,Al,Y)N	均一組成(Ti,Al,Y)N	2.9	1.27	1.14	2.9
比較例5	(Ti,Al,Y)CN	均一組成(Ti,AJ,Y)CN	3.0	1.28	1.14	3.0

【0030】実施例3と比較例4について実地試験1と同様にスクラッチ強度測定と切削試験を行い、その結果

* [0031]

【表 6】

を表6に示した。

*

試料名	スクラッチ強度	逃げ面摩耗量
	(N)	(mm)
実施例3	80	0.06
実施例4	85	0.05
比較例4	70	0.11
比較例 5	65	0.12

【0032】表6に示されるように実施例3,4は比較例4,5よりもスクラッチ強度が高く、逃げ面摩耗量VBも小さい。このことから実施例3,4は比較例4,5よりも被膜と基材の密着性が高く、耐摩耗性に優れていることが分かる。

※【実施試験3】ターゲットにTiAlMnCrを用い表 7に示す条件でコーティングした以外は実地試験1と同 様に行った。

[0034]

【表7】

[0033]

此料名	工程	ターケット	7-5	Y-9	基材電圧 ^{E2)}	7.	スロ	7 .	ス②	加	聘
			EE E1) (V)	電法 (A)	(V)	雅思	液量 (BCC341)	雅	按量 (BOCM)	熱量度	(分)
			('')							(3)	
実施例 5	加熱	_	_	-		_	-	-	-	500	60
	エッテンタ		40	120	-600	Ar	60	N,	70	500	15
	(TLALMa,Cr)NO	TiADiaCr	40	150	-35	N,	200		-	500	50
	(TLALME CONO	TIAIMSO	40	150	-35300 te =0	N ₂	200	_	-	500	20
	(TLALME, Cr)NO	TAIMaCr	40	150	-30	N ₂	200			500	10
比較何6	加熱	_	_		<u>"-</u>	-	-	_		500	60
	エッテンサ		40	120	-600	Ar	60	N ₁	70	500	15
	(TLALME, Cr)N	TLAUMDC	39	150	-50	N,	215	_	_	500	55

注1) 蒸発源の陽極と陰極の間のアーク電圧

注2) 基材と真空容器の間の基材電圧

注3) 基材電圧を-35Vから-70Vまで降下した後-70Vで4分間保持し、-70Vから-100Vまで降下した後-100Vで4分間保持し、-100Vから-150Vまで降下した後-150Vで4分間保持し、-150Vから-200Vまで降下した後-200Vで4分間保持し、-200Vから-300Vまで降下した後-300Vで4分間保持した。

【0035】使用ターゲット欄のTiAlMnCrは 成分原子比は(Ti, Al, Mn, Cr) = 46.1: (Ti, Al, Mn, Cr) = 45:45:5:5(原 43.9:4.2:5.8であり、比較例6についてエ 子比)のターゲットを示した。作製した試料の膜厚とT 50 ッジ稜線の近接部の(Ti, Al, Mn, Cr)N膜を

i / A 1 比を表 8 に示した。なお、基材電圧の低下させるとエッジ稜線の近接部のMn原子比はTiと同様に増加し、エッジ稜線の近接部のCr原子比はA 1 と同様に減少した。例えば、実施例 5 についてエッジ稜線の近接部の(Ti, Al, Mn, Cr) N膜を深さ方向に分析したところ基材側の金属成分原子比は(Ti, Al, Mn, Cr) = 46.1:43.9:4.2:5.8、中間部分の金属成分原子比は(Ti, Al, Mn, Cr) = 51.1:38.9:4.6:5.4、表面側の金属成分原子比は(Ti, Al, Mn, Cr) = 46.1:43.9:4.2:5.8であり、比較例 6 についてエ

15

深さ方向に分析したところ金属成分原子比は (Ti, Al, Mn, Cr) = 46.5:43.5:4.2:5.

*【0036】 【表8】

8であった。

試料名	被膜の種類	の種類 TiAl 化合物膜					
		構造	競 厚 (µ m)	エッジ近 接部の Ti/Al 比 (原子比)	エッジから2 mm離れた箇 所の Ti/Al 比 (原子比)	(µm)	
実施例 5	(Ti,Al,Ma,Cr)N	基材制(Ti,ALMIL,Cr)N	1.0	1.05	1.05	3.2	
	l	中間部分m.almi,cr)N	1.2	1.31			
		表面 倒 (Ti,Al,Ma,Cz)N	1.0	1.05]		
比較例 6	(Ti,Al,Mn,Cr)N	均一組成(Ti.ALMu,Cr)N	3.3	1.07	1.07	3.3	

【0037】実施例5と比較例6について実地試験1と同様にスクラッチ強度測定と切削試験を行い、その結果

%[0038]

【表 9】

を表9に示した。

*

試料名	スクラッチ強度	逃げ面摩耗量
	(N)	(mm)
実施例 5	80	0.06
比較例 6	40	0.12

【0039】表9に示されるように実施例5は比較例6 よりもスクラッチ強度が高く、逃げ面摩耗量VBも小さい。このことから実施例5は比較例6よりも被膜と基材の密着性が高く、摩耗しにくいことが分かる。

[0040]

【発明の効果】TiAl化合物膜被覆部材の耐摩耗性、耐酸化性、密着性にTiAl化合物膜被覆条件の基材電圧が影響をおよぼすという知見を得た。上述したようにTiAl化合物膜形成工程中に該真空容器と該基材間に印加する基材電圧を-20V~-300Vの範囲で連続 30的および/または段階的に降下させたのち上昇させるという調整を行いTiAl化合物膜を被覆したTiAl化合物膜被覆部材は従来のTiAl化合物膜被覆部材に比べて切削性能に優れる。本発明を応用した切削工具は従来の切削工具に比較して切削性能、特に耐摩耗性、耐酸

化性、密着性が向上するという効果を発揮するものであ る。

【図面の簡単な説明】

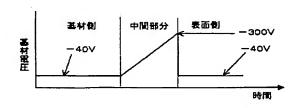
【図1】実施例1 (Ti, Al) N被覆工程において連続的に基材電圧を調整したことを示す基材電圧調整パターン図

【図2】実施例2(Ti, Al) N被覆工程において段階的に基材電圧を調整したことを示す基材電圧調整パターン図

【図3】実施例3(Ti,A1,Y)N被覆工程において連続的に基材電圧を調整したことを示す基材電圧調整パターン図

【図4】実施例5 (Ti, Al, Mn, Cr) N被覆工程において段階的に基材電圧を調整したことを示す基材電圧調整パターン図

[図1]



【図2】

